PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-017227

(43)Date of publication of application: 22.01.1999

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 09-171691

(71)Applicant: IWASAKI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

27.06.1997 (72)Invent

(72)Inventor: SUEHIRO YOSHINOBU

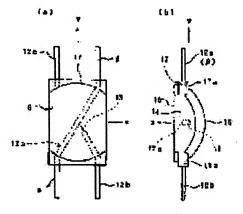
HATANAKA MITSUSACHI

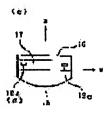
(54) REFLECTING TYPE LIGHT-EMITTING DIODE AND ARRAY BODY OF LIGHT-EMITTING DIODE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflecting type light-emitting diode and an array body of light-emitting diode capable of improving heat radiation, by stably holding the positional accuracy of a light-emitting element against a recessed surface type reflecting surface.

SOLUTION: A light emitting element 11 is mounted almost at the center of the first lead portion 12a, and the light-emitting element 11 and a second lead portion 12b are connected by a wire 13. The light-emitting element 11, a first lead portion 12a, a second lead portion 12b and a part of a third lead portion 12c are sealed by a light transmitting lateral 14. The third lead portion 12c is attached to a supporting portion 17. The first lead portion 12a is formed in such a manner that a recessed reflecting surface 15 is crossed almost linearly when the recessed reflecting surface 15 is seen from the front. An end portion a of the first lead portion and the second lead portion 12b, and an end portion βof the first lead portion 12a and the third lead portion 12c are taken out in a reverse direction each other from the side surface of the light transmitting material 14.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-17227

(43)公開日 平成11年(1999)1月22日

(51) Int.Cl.6

H01L 33/00

識別記号

FΙ

H01L 33/00

Η

N

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平9-171691

(22)出願日

平成9年(1997)6月27日

(71)出願人 000000192

岩崎電気株式会社

東京都港区芝3丁目12番4号

(72)発明者 末広 好伸

埼玉県行田市富士見町1丁目20番地 岩崎

電気株式会社開発センター内

(72)発明者 畠中 三幸

埼玉県北埼玉郡川里村赤城台362-26 岩

崎情報機器株式会社内

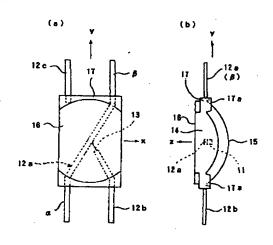
(74)代理人 弁理士 半田 昌男

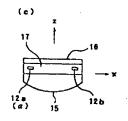
(54) 【発明の名称】 反射型発光ダイオード及び発光ダイオード配列体

(57)【要約】

【課題】 凹面状反射面に対する発光素子の位置精度を安定して保つことができると共に、放熱性の向上を図ることができる反射型発光ダイオード及び発光ダイオード配列体を提供する。

【解決手段】 発光素子11は第一リード部12aの略中央部にマウントされ、発光素子11と第二リード部12bとはワイヤ13により接続される。発光素子11と第一リード部12a、第二リード部12b及び第三リード部12cの一部とは光透過性材料14により封止される。第三リード部12cは、支持部17に取り付けられる。第一リード部12aは、凹面状反射面15を正面から見たときに凹面状反射面15を略直線状に横切るように形成される。第一リード部12aの端部α及び第二リード部12bと、第一リード部12aの端部β及び第三リード部12cとは、光透過性材料14の側面から互いに反対方向に引き出される。





20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光素子と、前記発光素子がマウントさ れた第一リード部と、前記発光素子とワイヤを介して接 続された第二リード部と、前記発光素子の発光面に対向 して設けられた凹面状反射面と、前記凹面状反射面で反 射した光を外部に放射する放射面と、前記発光素子と前 記第一リード部及び第二リード部の一部とを封止すると 共に前記凹面状反射面と前記放射面との間の空間を埋め る光透過性材料とを備える反射型発光ダイオードにおい て、

前記第一リード部は前記凹面状反射面を正面から見たと きに前記凹面状反射面を略直線状に横切るように形成さ れ、且つ、前記第一リード部の両端部が前記光透過性材 料の側面から外部に引き出されていることを特徴とする 反射型発光ダイオード。

【請求項2】 前記第一リード部及び前記第二リード部 は、プレス打ち抜き加工で作製したリードフレームを用 いて形成されたものであることを特徴とする請求項1記 載の反射型発光ダイオード。

【請求項3】 前記凹面状反射面の周辺部に位置する前 記光透過性材料に取り付けられた第三リード部を有し、 前記第一リード部の一方の端部及び前記第二リード部 と、前記第一リード部の他方の端部及び前記第三リード 部とが、前記光透過性材料の側面から互いに反対方向に 引き出されていることを特徴とする請求項1又は2記載 の反射型発光ダイオード。

【請求項4】 一方の端部が前記第一リード部の前記発 光素子がマウントされた部分に連なり、他方の端部が前 記光透過性材料の側面から外部に引き出されている第四 リード部を有することを特徴とする請求項1又は2記載 30 の反射型発光ダイオード。

【請求項5】 前記第一リード部の一方の端部及び前記 第二リード部と、前記第一リード部の他方の端部及び前 記第四リード部の他方の端部とが、前記光透過性材料の 側面から互いに反対方向に引き出されていることを特徴 とする請求項4記載の反射型発光ダイオード。

【請求項6】 請求項1乃至5記載の反射型発光ダイオ ードを一列に配列したことを特徴とする発光ダイオード 配列体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光素子が発する 光を凹面状反射面で反射した後に外部に放射する反射型 発光ダイオード及びその反射型発光ダイオードを配列し た発光ダイオード配列体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、種々の構造の発光ダイオード が案出されており、その代表的なものとして、例えば、 レンズ型発光ダイオードと、反射型発光ダイオードとが ある。レンズ型発光ダイオードは、発光素子が発する光 50 を直接、光学面から外部に放射するものである。

【0003】図5 (a) は従来の反射型発光ダイオード の概略正面図、図5(b)はその反射型発光ダイオード を x 軸方向から見たときの概略側面図、図5 (c) はそ の反射型発光ダイオードをy軸方向から見たときの概略 側面図である。図5に示す反射型発光ダイオードは、発 光素子61と、リード部62a, 62b, 62c, 62 dと、ワイヤ63と、光透過性材料64と、発光素子6 1の発光面に対向して形成された凹面状反射面65と、

10 発光素子の背面側に形成された放射面66とを有する。 発光素子61はリード部62aの一方の端部にマウント され、発光素子61とリード部62bとはワイヤ63に より電気的に接続されている。また、発光素子61、リ ード部 6 2 a , 6 2 b , 6 2 c , 6 2 d の先端部及びワ イヤ63は、光透過性材料64により封止されている。 リード部62a, 62bとリード部62c, 62dと は、光透過性材料64の両側面から互いに反対方向に引 き出されている。リード部62c,62dは、電気配線 には無関係で、反射型発光ダイオードを基板に固定する ためにだけ用いられるものである。凹面状反射面65 は、光透過性材料64の下面をメッキや金属蒸着等によ り鏡面加工したものである。

【0004】かかる反射型発光ダイオードを作製するに は、リードフレームを用い、そのリードフレームに反射 型発光ダイオードをトランスファーモールド法で成形す る。トランスファーモールド法を用いると、リードフレ ームがしっかりと保持された状態で凹面状反射面65及 び放射面66を成形することができるため、発光素子6 1と光学系との位置精度を高くできる。その後、リード フレームの不要部分を切断することにより、図5に示す ようなリード部62a、62b、62c、62dを有す る反射型発光ダイオードが得られる。

【0005】発光素子61に電力が供給されると、発光 素子61が発光し、発光素子61が発する光は凹面状反 射面65によって反射された後、放射面66から外部に 放射されるので、発光素子62が発する光を有効に前方 に放射することができる。特に、発光素子61からその 中心軸方向(z軸方向)に放射された光だけでなく、発 光素子61からz軸方向に略直交する方向に放射された 40 光も凹面状反射面65で制御されるので、反射型発光ダ イオードは、外部放射効率が高いという特徴がある。こ の点で、発光素子からその中心軸方向に略直交する方向 に放射された光を有効に外部放射することができないレ ンズ型発光ダイオードとは異なる。

【0006】また、反射型発光ダイオードはレンズ型発 光ダイオードに比べて薄型化を図ることができる。この ため、発光素子61を樹脂封止する際に、樹脂収縮の影 響が少ないので、凹面状反射面65の直径を大きくする ことができるという利点もある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、リードフレ ームの作製方法には、一般に、エッチング加工による方 法とプレス打ち抜き加工による方法とがある。エッチン グ加工では、版作成費用が少なく、その作成も容易であ る。これに対し、プレス打ち抜き加工では、型作成に費 用が多くかかり、その作成は容易でないが、量産性の点 でエッチング加工よりも優れている。このため、レンズ 型発光ダイオードを含めた多くの発光ダイオードでは、 リードフレームとしてプレス打ち抜き加工品が用いられ 作製する場合、リード部の幅が狭いほど、リード部の端 部に対応する部分がリードフレームの面に垂直な方向に ずれる現象、いわゆるリードの跳ね上がり現象が顕著と

【0008】反射型発光ダイオードでは、発光素子61 を、凹面状反射面65を正面からみたときの中心位置に 配置するため、リード部62aの一方の端部はその中心 位置まで引き伸ばしている。しかし、凹面状反射面65 を正面から見たときに放射面66と重なるリード部62 a, 62bの部分は、凹面状反射面65で反射された光 を遮ることになるので、リード部62a,62bの幅は なるべく狭くする必要がある。このため、プレス打ち抜 き加工で作製したリードフレームを用いて反射型発光ダ イオードを作製すると、リードの跳ね上がり現象によ り、リード部62aの発光素子61をマウントする部分 が2軸方向にずれてしまい、凹面状反射面65に対する 発光素子61の位置精度が悪くなるという問題があっ た。これにより、発光素子61から2軸方向以外の方向 に放射される光は凹面状反射面65で良好に制御され ず、光放射特性がばらつき、目的の特性からずれてしま う。ここで、リードの跳ね上がり現象によるリード部6 2 a の発光素子61をマウントする部分の z 軸方向のず れは、凹面状反射面65の直径を大きくするほど顕著と なる。

【0009】本発明者等は、リードの跳ね上がり現象が 反射型発光ダイオードの光放射特性に及ぼす影響を調べ るため、シミュレーションを行った。このシミュレーシ ョンでは、二種類の反射型発光ダイオードD1, D2を 用いて、放射面66から100mm離れた目標の平面上 での照射分布を調べた。反射型発光ダイオードDiは、 略平行光を導出するように、凹面状反射面65を、発光 素子61を焦点とする回転放物面に近似した形状とした ものである。かかる回転放物面に近似した形状は、具体 的には、図6に示すように、凹面状反射面65の中心軸 方向を2軸(凹面状反射面65の後側を2正軸とす る。)、リードフレーム面を含む平面をX-Y平面とす ると、曲面

 $Z = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_4 + A_4$ $5 r^5 + A_6 r^6 + A_7 r^7$

り、また、

 $A_0 = 2.587701467893$

 $A_1 = 0.054300378443$

 $A_2 = -0.203370511165$

 $A_3 = 0.099854956816$

 $A_4 = -0.052141059283$

 $A_5 = 0.014504319626$ $A_6 = -0.002048212706$

 $A_7 = 0.000115311060$

ている。但し、プレス打ち抜き加工でリードフレームを 10 である。一方、反射型発光ダイオード D_2 は、反射型発 光ダイオードD: において発光素子61を2軸方向に 0. 1 mmだけずらして配置したものである。

> 【0010】図7 (a) は反射型発光ダイオードD」に ついての照射分布シミュレーション結果を示す図、図7 (b) は反射型発光ダイオードD2 についての照射分布 シミュレーション結果を示す図である。ここで、図7 (a) 及び図7 (b) は、ピーク照度を100%とした 場合の、照度の割合の分布を表し、また、照度の割合が 60%以上の部分を梨地状にして示している。反射型発 光ダイオードD1 では、図7 (a) に示すように、ピー ク照度の60%以上の分布が円状であり、目標の平面上 に平行光を照射することができる。一方、反射型発光ダ イオードD2 については、図7 (b) に示すように、照 度分布が図7(a)の照度分布よりも広がり、ピーク照 度が数割低下する。しかも、反射型発光ダイオードD2 では、ピーク照度の60%以上の分布がドーナツ状にな り、目標の平面上における凹面状反射面65の中心軸付 近の照度が大幅に低下する。したがって、リードがわず かに跳ね上がっても、反射型発光ダイオードの光放射特 性は大きな影響を受ける。

> 【0011】尚、レンズ型発光ダイオードでは、反射型 発光ダイオードのようにリード部の幅を狭くしなければ ならないという制限はない。これは、レンズ型発光ダイ オードは、発光素子が発する光を直接、光学面から外部 に放射するので、リード部が光を遮ることはないからで ある。また、レンズ型発光ダイオードでは、発光素子か らその中心軸方向に略直交する方向に放射された光を十 分制御できないので、発光素子の中心軸方向における発 光素子の位置ずれは、光放射特性にほどんど影響を及ぼ すことはない。このため、プレス打ち抜き加工で作製し たリードフレームを用いてレンズ型発光ダイオードを作 製しても、何ら問題はない。

【0012】また、従来の反射型発光ダイオードでは、 発光素子61をリード部62aの一方の端部にマウント したことにより、発光素子61が発した熱はリード部6 2 a の他方の端部に向かって一方向にしか伝わることが できない。このため、発光素子61が発した熱は、リー ド部62aの他方の端部の側のみから外部に放射される ので、放熱性が良くないという問題があった。また、か で与えられる。ここで、 $\mathbf{r}=(\mathbf{X}^2+\mathbf{Y}^2)^{1/2}$ であ 50 かる放熱性の問題は、特に、複数の反射型発光ダイオー

20

ドを配列した発光ダイオード配列体において顕著であ る。

【0013】本発明は上記事情に基づいてなされたもの であり、凹面状反射面に対する発光素子の位置精度を安 定して保つことができると共に、放熱性の向上を図るこ とができる反射型発光ダイオード及び発光ダイオード配 列体を提供することを目的とするものである。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めの本発明は、発光素子と、前記発光素子がマウントさ れた第一リード部と、前記発光素子とワイヤを介して接 続された第二リード部と、前記発光素子の発光面に対向 して設けられた凹面状反射面と、前記凹面状反射面で反 射した光を外部に放射する放射面と、前記発光素子と前 記第一リード部及び第二リード部の一部とを封止すると 共に前記凹面状反射面と前記放射面との間の空間を埋め る光透過性材料とを備える反射型発光ダイオードにおい て、前記第一リード部は前記凹面状反射面を正面から見 たときに前記凹面状反射面を略直線状に横切るように形 成され、且つ、前記第一リード部の両端部が前記光透過 性材料の側面から外部に引き出されていることを特徴と するものである。

【0015】第一リード部を、凹面状反射面を正面から 見たときに凹面状反射面を略直線状に横切るように形成 したことにより、発光素子は第一リード部の略中央部に マウントされる。このような第一リード部を有するリー ドフレームをプレス打ち抜き加工で作製しても、第一リ ード部の発光素子をマウントする部分は加工による変形 が極めてわずかである。このため、かかるリードフレー ムを用いて反射型発光ダイオードを作製することによっ て、凹面状反射面に対する発光素子の位置精度を安定し て保つことができるので、発光素子からその中心軸方向 に放射される光だけでなく、その中心軸方向に略直交す る方向に放射される光も凹面状反射面で良好に制御さ れ、安定した光放射特性を有する光として外部に放射す ることができる。

【0016】また、第一リード部の両端部を光透過性材 料の側面から外部に引き出したことにより、発光素子が 発した熱は第一リード部の両端部に向かって両方向に伝 わることができるため、発光素子から第一リード部に伝 40 わる熱を第一リード部の両端部から外部に放射すること ができると共に、発光素子から第一リード部に伝わる熱 の一部を放射面から外部に放射することができるので、 放熱性の向上を図ることができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下に本発明の一実施形態につい て図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施形態 である反射型発光ダイオードを用いた発光ダイオード配 列体の概略正面図、図2はその発光ダイオード配列体の A-A矢視方向概略断面図、図3 (a) は本実施形態の 50 一方の面上にメッキや金属蒸着等により鏡面加工したも

反射型発光ダイオードの概略正面図、図3(b)はその 反射型発光ダイオードをx軸方向から見たときの概略側 面図、図3(c)はその反射型発光ダイオードをy軸方 向から見たときの概略側面図である。尚、図3におい て、z軸は凹面状反射面の中心軸方向、x軸及びy軸は 発光ダイオードの発光面を含む平面における直交座標軸

【0018】図1及び図2に示す発光ダイオード配列体 は、複数の反射型発光ダイオード10と、基板30と、 二つの細長い板状のスペーサ40とを備えるものであ る。本実施形態では、複数の反射型発光ダイオード10 を直線状に配列して線状光源を得る場合について説明す る。反射型発光ダイオード10は、図2及び図3に示す ように、発光素子11と、第一リード部12aと、第二 リード部12bと、第三リード部12cと、ワイヤ13 と、光透過性材料14と、凹面状反射面15と、放射面 16と、支持部17とを備える。

【0019】第一リード部12a及び第二リード部12 bは、発光素子11に電力を供給するために用いられ る。発光素子11は第一リード部12aの略中央部にマ ウントされ、発光素子11と第二リード部12bとはワ イヤ13により電気的に接続されている。また、発光素 子11、第一リード部12aの一部、第二リード部12 bの先端部、第三リード部12cの先端部及びワイヤ1 3は、熱硬化性の光透過性材料14により一体的に封止 されている。ここで、光透過性材料14としては、例え ば、屈折率1.5の透明エポキシ樹脂が用いられる。

【0020】第一リード部12aは、凹面状反射面15 を正面から見たときに凹面状反射面15を略直線状に横 30 切るように形成され、第一リード部 12aの両端部 α , βは光透過性材料14の側面から外部に引き出されてい る。第三リード部12cは、支持部17に取り付けられ る。第一リード部12αの一方の端部α及び第二リード 部12bと、第一リード部12aの他方の端部β及び第 三リード部12cとは、光透過性材料14の側面から互 いに反対方向に引き出される。

【0021】また、第一リード部12aの端部β及び第 三リード部12cは、電気的端子となる第一リード部1 2 a の端部 α 及び第二リード部 1 2 b とは異なり、電気 配線には無関係で、反射型発光ダイオード10を基板3 0に固定するために用いられる。このため、第一リード 部12aの端部β及び第三リード部12cは固定用リー ドということができる。一方、第一リード部12aの端 部α及び第二リード部12bは、発光素子11に電力を 供給するのみならず、反射型発光ダイオード10を基板 30に固定するためにも用いられる。このため、第一リ ード部12aの端部α及び第二リード部12bは電力供 給兼固定用リードということができる。

【0022】凹面状反射面15は、光透過性材料14の

のであり、発光素子11の発光面に対向する側に形成されている。ここでは、凹面状反射面15を、発光素子11の発光面の中心を焦点とする回転放物面形状に形成する。一方、放射面16は、発光素子11の背面側であって、第一リード部12aと第二リード部12bに近い位置に形成されている。ここでは、放射面16を凹面状反射面15の回転軸(z軸)に垂直な平面形状に形成する。すなわち、本実施形態では、反射型発光ダイオード10が平行光を発することができるように、発光素子11の位置、凹面状反射面15及び放射面16の形状を設 10

計している。

【0023】また、反射型発光ダイオード10は、凹面 状反射面15を正面から見たときに凹面状反射面15の 中心を通る直線であって凹面状反射面15の中心軸に直 交する直線(例えば x 軸)に対して垂直な二つの平面に よって凹面状反射面15の端部が左右対称に切断されて いる。ここでは、凹面状反射面15を正面から見たとき に x 軸の方向における切断前の凹面状反射面15の長さ に対する切断後の凹面状反射面15の長さの割合が0. 7となるように、凹面状反射面15の端部を切断してい 20 る。このように凹面状反射面15の端部を切断するの は、凹面状反射面15の端部を切断するの は、凹面状反射面15の端部を切断するの は、凹面状反射面15の場部を切断するの は、凹面状反射面15の切断面が隣合うように発光ダイ オード10を直線状に配列することにより、発光ダイオ ード10の配列間隔を狭くするためである。

【0024】支持部17は、反射型発光ダイオード10を、スペーサ40を介して基板30に取り付ける場合に、反射型発光ダイオード10を支持する役割を果たすものである。支持部17は、凹面状反射面15の周辺部に形成される。本実施形態では、凹面状反射面15の端部を左右対称に切断しているので、支持部17は、図3(a)に示すように、凹面状反射面15の上下に形成されることになる。また、支持部17の下端面17a(図3(b)参照)は平面状に形成している。

【0025】かかる反射型発光ダイオード10を作製す るには、リードフレームを用い、そのリードフレームに 反射型発光ダイオードをトランスファーモールド法で形 成する。このトランスファーモールド法を用いると、凹 面状反射面15、放射面16及び支持部17を精度よく 成形できるので、それらの形状は非常に安定しており、 さらに、リードフレームがしっかりと保持された状態で 40 凹面状反射面15及び放射面16を成形することができ るため、発光素子11と光学系との位置精度を高くでき る。また、リードフレームとしては、量産性を考慮し、 プレス打ち抜き加工品が用いられる。次に、リードフレ ームの不要部分を切断することにより、図3に示すよう な各リード部12a, 12b, 12cを有する反射型発 光ダイオード10が得られる。最終的に、反射型発光ダ イオード10は、光透過性材料14から外部に引き出さ れた各リード部12a、12b、12cを裏面側に折り 曲げた状態に加工される。

【0026】上記構成の反射型発光ダイオード10では、発光素子11に電力が供給されると、発光素子11が発光し、発光素子11が発する光は凹面状反射面15により反射され、放射面16より外部に放射される。このように発光素子11が発する光を一度、凹面状反射面15で反射した後に外部に放射するので、かかる反射型発光ダイオード10は、外部放射効率が高く、高輝度・高光度であるという特徴がある。しかも、発光素子11が発する光は凹面状反射面15のみで制御されるため、反射型発光ダイオード10自体の照射分布には特徴だった照射パターンがなく、照射むらの度合いが小さいので、均斉度の向上を図ることができる。

【0027】基板30には、図2に示すように、反射型発光ダイオード10の各リード部12a, 12b, 12 cを挿入するためのリード差込用孔31が形成されている。このリード差込用孔31は、複数の反射型発光ダイオード10を凹面状反射面15の切断面が隣合うように一列に配列したときのリード位置に対応した箇所に設けられる。複数の反射型発光ダイオード10は、第一リード部12aの端部α及び第二リード部12bと、第一リード部12aの端部β及び第三リード部12cとが配列方向に対して両側に位置するように基板30に配列して取り付けられることになる。また、基板30の裏面(基板30上に反射型発光ダイオード10を配列する側の面と反対側の面)には回路パターン(不図示)が形成されている。

【0028】スペーサ40は、四角柱形状のものであっ て、凹面状反射面15の底部が基板30に接触しないよ うに、支持部17と基板30との間に挿入するものであ 30 る。スペーサ40の長さは、複数の反射型発光ダイオー ド10を一列に配列したときの長さと略同じであり、そ の高さは、凹面状反射面15の底部が基板30に接触し ない高さとしている。各スペーサ40は、図1及び図2 に示すように、複数の反射型発光ダイオード10を凹面 状反射面15の切断面が隣合うように一列に配列したと きに、複数の反射型発光ダイオード10の配列方向に対 して両側の各々に位置する支持部17について共通に用 いられる。また、スペーサ40には、図2に示すよう に、リード差込用孔41が形成されている。このリード 差込用孔41は、複数の反射型発光ダイオード10を一 列に配列したときのリード位置に対応した箇所に設けら れる。

【0029】反射型発光ダイオード10を用いて発光ダイオード配列体を形成するには、まず、複数の反射型発光ダイオード10の各リード部12a,12b,12cを、スペーサ40に形成されたリード差込用孔41に挿入すると共に、基板30に形成されたリード差込用孔31に挿入して、支持部17の下端面17aをスペーサ40の表面に当接させることにより、複数の反射型発光ダ

50 イオード10を、スペーサ40を介して基板30に取り

30

10

付ける。次に、各リード部12a, 12b, 12cを半田付けすることにより、反射型発光ダイオード10を固定すると共に、第一リード部12aの端部α及び第二リード部12bを基板30上に形成された回路パターンと接続する。こうして、複数の反射型発光ダイオード10は、凹面状反射面15の切断面が隣合うように直線状に配列され、図1に示すような発光ダイオード配列体が得られる。尚、図1に示す発光ダイオード配列体からは、二本の外部接続用の線50が引き出されている。

【0030】このように、凹面状反射面15の端面を切 断した面が隣合うように密に反射型発光ダイオード10 を配列することにより、高照度で且つ均斉度よく、線状 のエリアを照射する光源とすることができる。本実施形 態の反射型発光ダイオードでは、発光素子をマウントす る第一リード部を、凹面状反射面を正面から見たときに 凹面状反射面を略直線状に横切るように形成したことに より、発光素子は第一リード部の略中央部にマウントさ れ、かかる第一リード部を有するリードフレームをプレ ス打ち抜き加工で作製しても、第一リード部の発光素子 をマウントする部分は加工による変形が極めてわずかで 20 ある。このため、かかるリードフレームを用いて反射型 発光ダイオードを作製することにより、凹面状反射面に 対する発光素子の位置精度を安定して保つことができる ので、発光素子からその中心軸方向に放射される光だけ でなく、その中心軸方向に略直交する方向に放射される 光も凹面状反射面で良好に制御され、安定した平行光を 効率よく外部に放射することができる。

【0031】また、本実施形態の反射型発光ダイオード では、第一リード部の両端部を光透過性材料の側面から 引き出したことにより、発光素子が発した熱は第一リー ド部の両端部に向かって両方向に伝わり、発光素子から 第一リード部に伝わる熱を第一リード部の両端部から外 部に拡散することができるので、放熱性の向上を図るこ とができる。このため、発光素子の温度上昇により発光 出力が低下するのを防止することができると共に、発光 素子の寿命特性が劣化するのを防ぐことができる。とこ ろで、反射型発光ダイオードは薄型で、第一リード部が 放射面に近い位置に形成されているため、発光素子から 第一リード部に伝わる熱の一部は放射面から外部に放射 される。本実施形態では、凹面状反射面を正面から見た ときに第一リード部が放射面と重なる部分の割合は従来 の反射型発光ダイオードのものに比べて大きいので、放 射面から外部に放射する熱の量を増やすことができ、こ のことによっても放熱性が向上する。

【0032】本発明者等は、下記の各発光ダイオードについて、消費電力36mWで発光素子を約10分程度点灯し、発光素子のジャンクション温度が安定したことを確かめた後、発光素子のジャンクション温度上昇を測定した。その結果、従来の反射型発光ダイオードでは6.0°、本実施形態の反射型発光ダイオードでは4.8 50

。、エポキシ樹脂でモールド成形したレンズ型発光ダイオードでは9.2°であった。したがって、本実施形態の反射型発光ダイオードでは、従来の反射型発光ダイオードに比べて、発光素子のジャンクション温度上昇が80%に低減することを確認した。

【0033】また、本実施形態の反射型発光ダイオード 用いて発光ダイオード配列体を構成することにより、発 光素子が発する熱を、第一リード部からの放熱の経路及 び放射面からの放熱の経路で、広く外部に拡散すること 10 ができるので、放熱性の向上を図り、発光素子の温度上 昇を効果的に抑えることができる。尚、本発明は上記の 実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内 において種々の変形が可能である。

【0034】たとえば、上記の実施形態において、凹面状反射面に対する発光素子の位置精度を安定して保つだけで、放熱性の向上を図る必要がない場合には、図3に示す第一リード部12aの β 側の幅を、 α 側の幅によりも狭くしてもよい。また、上記の実施形態では、リードフレームとして、量産性を考慮し、プレス打ち抜き加工品を用いた場合について説明したが、量産性の向上を図る必要がない場合には、リードフレームとして、エッチング加工により作製したものを用いてもよい。

【0035】更に、上記の実施形態では、支持部に取り 付けられた第三リード部を有する場合について説明した が、第三リード部の代わりに、例えば、図4に示すよう に、一方の端部が第一リード部12aの発光素子がマウ ントされた部分Pに連なり、他方の端部が光透過性材料 の側面から外部に引き出されている第四リード部12d を設けるようにしてもよい。ここで、第一リード部12 aの端部α及び第二リード部12bと、第一リード部1 2 a の端部β及び第四リード部12dの他方の端部と は、光透過性材料の側面から互いに反対方向に引き出さ れる。これにより、発光素子が発する熱の放熱経路が増 えるため、発光素子から第四リード部12dに伝わる熱 を第四リード部12dの端部から外部に放射することが できると共に、発光素子から第四リード部12dに伝わ る熱の一部を放射面16から外部に放射することができ るので、放熱性をより一層向上させることができる。

【0036】一般に、反射型発光ダイオードでは、凹面 状反射面を正面から見たときに放射面と重なるリード部 の部分は、発光素子が発し、凹面状反射面で反射する光 を外部に放射するのを妨げることになる。凹面状反射面 の直径を約10mm、リード部の幅を約0.3mmとし た場合、従来の反射型発光ダイオードでは、リード部に よる外部放射の損失は約6~7%であり、一方、図4に 示す反射型発光ダイオードでは、リード部による外部放 射の損失は約10%程度で、従来の反射型発光ダイオー ドに比べて約2倍弱となる。しかし、平行光を外部に放 射する仕様では、反射型発光ダイオードは、レンズ型発 光ダイオードに比べて3倍以上の外部放射効率を有する

光ダイオードをy軸方向から見たときの概略側面図である。

12

ことを考慮すると、図4に示す反射型発光ダイオードの 損失と従来の反射型発光ダイオードの損失との差は小さ なものと考えることができる。図4に示す反射型発光ダ イオードは、特に、大電流を通電するタイプのものに好 適である。

【図4】本実施形態の反射型発光ダイオードの変形例を 説明するための図である。

[0037]

【図5】(a)は従来の反射型発光ダイオードの概略正面図、(b)はその反射型発光ダイオードを x 軸方向から見たときの概略側面図、(c)はその反射型発光ダイオードを y 軸方向から見たときの概略側面図である。

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、第 一リード部を、凹面状反射面を正面から見たときに凹面 状反射面を略直線状に横切るように形成し、且つ、第一 リード部の両端部を光透過性材料の側面から外部に引き 出したことにより、発光素子は第一リード部の略中央部 にマウントされ、かかる第一リード部を有するリードフ レームをプレス打ち抜き加工で作製しても、第一リード 部の発光素子をマウントする部分は加工による変形が極 めてわずかであるので、凹面状反射面に対する発光素子 の位置精度を安定して保つことができ、しかも、発光素 子が発した熱は第一リード部の両端部に向かって両方向 に伝わることができるため、発光素子から第一リード部 に伝わる熱を第一リード部の両端部から外部に放射する ことができると共に、発光素子から第一リード部に伝わ 20 る熱の一部を放射面から外部に放射することができるの で、放熱性の向上を図ることができる反射型発光ダイオ ードを提供することができる。

【図 6】 照射分布シミュレーションに用いられる反射型 10 発光ダイオードの凹面状反射面の形状を説明するための 図である。

【図7】 照射分布シミュレーション結果を示す図であ

【符号の説明】

10 反射型発光ダイオード

11 発光素子

12a 第一リード部

12b 第二リード部

12c 第三リード部

12d 第四リード部

13 ワイヤ

14 光透過性材料

15 凹面状反射面

16 放射面

17 支持部

17a 下端面

30 基板

31 リード差込用孔

40 スペーサ

41 リード差込用孔

50 外部接続用の線

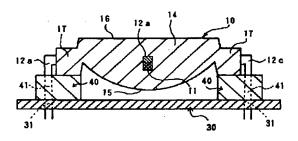
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態である反射型発光ダイオードを用いた発光ダイオード配列体の概略正面図である。 【図2】その発光ダイオード配列体のA-A矢視方向概

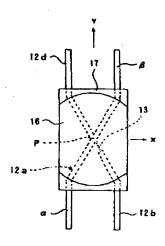
【図2】その発光タイオード配列体のA-A矢視方向機略断面図である。

【図3】(a)は本実施形態の反射型発光ダイオードの 概略正面図、(b)はその反射型発光ダイオードをx軸 30 方向から見たときの概略側面図、(c)はその反射型発

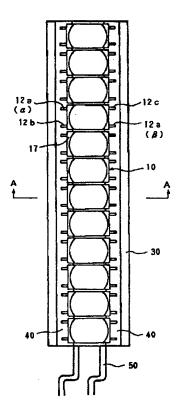
【図2】



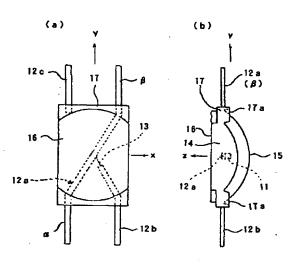
【図4】

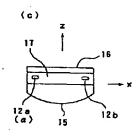


【図1】

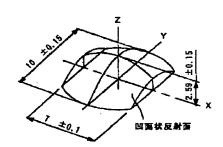


【図3】





【図6】

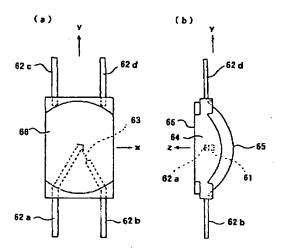


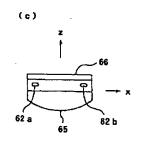
2. 587701467893

0. 054300378443

-0. 002048212706 0. 000115311060

【図5】





[図7]

